

XXIII Международный симпозиум "Нанозеллектроника" , Нижний Новгород, 11- 14 марта 2019 г.	
Абрамкин Д.С., Петрушков М.О., Путято М.А., Семягин Б.Р., Емельянов Е.А., Преображенский В.В., Гутаковский А.К., Шамирзаев Т.С.	
XXIII Международный симпозиум Нанозеллектроника", Нижний Новгород, 11-14 марта 2019 г. Гетероструктуры с GaAs/GaP-квантовыми ямами, выращенные на Si-подложках	1167
Барышев В.Р., Гинзбург Н.С., Заславский В.Ю., Малкин А.М.	
Использование двухзеркальных двумерных брэгговских резонаторов в полупроводниковых гетеролазерах	1172
Уточкин В.В., Алёшкин В.Я., Дубинов А.А., Гавриленко В.И., Куликов Н.С., Фадеев М.А., Румянцев В.В., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Морозов С.В.	
Исследование пороговой энергии оже-рекомбинации в волноводных структурах с квантовыми ямами HgTe/Cd_{0.7}Hg_{0.3}Te в области 14 мкм	1178
Дорохин М.В., Демина П.Б., Ерофеева И.В., Здоровейщев А.В., Кузнецов Ю.М., Болдин М.С., Попов А.А., Ланцев Е.А., Боряков А.В.	
Легирование термоэлектрических материалов на основе твердых растворов SiGe в процессе их синтеза методом электроимпульсного плазменного спекания	1182
Фатеев Д.В., Машинский К.В., Моисеенко И.М., Попов В.В.	
Боковой перенос энергии при возбуждении плазмонов терагерцовой волной в периодической пространственно несимметричной графеновой структуре	1189
Трифонов А.В., Игнатъев И.В., Кавокин К.В., Кавокин А.В., Шапочкин П.Ю., Ефимов Ю.П., Елисеев С.А., Ловцюс В.А.	
Подавление электронно-дырочного обменного взаимодействия в резервуаре неизлучающих экситонов	1195
Ивченко Е.Л., Калевич В.К., Kupold A., Valocchi A., Marie X., Amand T.	
Сверхтонкое взаимодействие и рекомбинация Шокли--Рида--Холла в полупроводниках	1200
Климов А.Э., Акимов А.Н., Ахундов И.О., Голяшов В.А., Горшков Д.В., Ищенко Д.В., Сидоров Г.Ю., Супрун С.П., Тарасов А.С., Эпов В.С., Терещенко О.Е.	
Динамика поверхностной проводимости в пленках PbSnTe : In с составом вблизи инверсии зон	1207
Мизеров А.М., Тимошнев С.Н., Никитина Е.В., Соболев М.С., Шубин К.Ю., Березовская Т.Н., Мохов Д.В., Лундин В.В., Николаев А.Е., Буравлев А.Д.	
Особенности МПЭ ПА синтеза слоев n⁺-GaN на виртуальных подложках GaN/c-Al₂O₃	1212
Оболенская Е.С., Иванов А.С., Павельев Д.Г., Козлов В.А., Васильев А.П.	
Сравнение особенностей транспорта электронов и субтерагерцовой генерации в диодах на основе 6-, 18-, 30-, 70- и 120-периодных сверхрешеток GaAs/AlAs	1218
Козлов Д.В., Румянцев В.В., Морозов С.В.	
Спектр двойных акцепторов в слоях барьеров и квантовых ям гетероструктур HgTe/CdHgTe	1224
Охапкин А.И., Юнин П.А., Дроздов М.Н., Королев С.А., Краев С.А., Архипова Е.А., Скороходов Е.В., Бушуйкин П.А., Шашкин В.И.	
Плазмохимическое осаждение алмазоподобных пленок на поверхности монокристаллического высоколегированного алмаза	1229
Планкина С.М., Вихрова О.В., Звонков Б.Н., Зубков С.Ю., Крюков Р.Н., Нежданов А.В., Павлов Д.А., Пашенькин И.Ю., Сушков А.А.	
Комплексное применение спектроскопии комбинационного рассеяния света и фотолюминесценции для диагностики многослойных гетероструктур	1233
Полищук О.В., Фатеев Д.В., Попов В.В.	
Усиление терагерцового излучения высокодобротными резонансными плазмонами в двухслойной периодической структуре на основе графена в режиме антикроссинга плазмонных мод	1237

- Румянцев В.В., Маремьянин К.В., Фокин А.П., Дубинов А.А., Уточкин В.В., Глявин М.Ю., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Морозов С.В., Гавриленко В.И.
Получение второй гармоники излучения субтерагерцовых гиротронов при удвоении частоты в InP : Fe и ее использование для магнитоспектроскопии полупроводниковых структур 1244
- Пузанов А.С., Венедиктов М.М., Оболенский С.В., Козлов В.А.
Расчетно-экспериментальное моделирование обратимых сбоев ячеек статической памяти субмикронных микросхем при воздействии потоков нейтронов 1250
- Суханов А.А., Сабликов В.А.
Спиновые состояния электронов в двойной квантовой точке в двумерном топологическом изоляторе со спин-орбитальным взаимодействием 1257
- Шастин В.Н., Жукавин Р.Х., Ковалевский К.А., Цыпленков В.В., Румянцев В.В., Шенгуров Д.В., Павлов С.Г., Шуман В.Б., Порцель Л.М., Лодыгин А.Н., Астров Ю.А., Абросимов Н.В., Klorpf J.M., Hubers H.-W.
Химический сдвиг и энергия обменного взаимодействия 1s состояний доноров магния в кремнии. Возможность стимулированного излучения 1263
- Шенгуров В.Г., Филатов Д.О., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Алябина Н.А., Зайцев А.В.
Туннельные диоды на базе эпитаксиальных структур n⁺-Ge/p⁺-Si(001), выращенных методом горячей проволоки 1267
- Сушков А.А., Павлов Д.А., Шенгуров В.Г., Денисов С.А., Чалков В.Ю., Байдусь Н.В., Рыков А.В., Крюков Р.Н.
Исследования поперечного среза и фотолюминесценции слоя GaAs, выращенного на подложке Si/Al₂O₃ 1271
- Умнягин Г.М., Дегтярев В.Е., Оболенский С.В.
Численное моделирование вольт-амперных характеристик двуслойной резистивной памяти на основе нестехиометрических оксидов металлов 1275
- Забавичев И.Ю., Потехин А.А., Пузанов А.С., Оболенский С.В., Козлов В.А.
Моделирование образования каскада смещений и переходных ионизационных процессов в кремниевых полупроводниковых структурах при нейтронном воздействии 1279
- Жукавин Р.Х., Павлов С.Г., Pohl A., Абросимов Н.В., Riemann H., Redlich B., Hubers H.-W., Шастин В.Н.
Стимулированное терагерцовое излучение доноров висмута в одноосно-деформированном кремнии при внутрицентровом оптическом возбуждении 1285
- Хребтов А.И., Резник Р.Р., Убийвовк Е.В., Литвин А.П., Скурлов И.Д., Парфёнов П.С., Кулагина А.С., Данилов В.В., Цырлин Г.Э.
Безызлучательный перенос энергии в гибридных наноструктурах с различной размерностью 1289
- Прохоров Д.С., Шенгуров В.Г., Денисов С.А., Филатов Д.О., Здравейщев А.В., Чалков В.Ю., Зайцев А.В., Ведь М.В., Дорохин М.В., Байдакова Н.А.
Усиленная фотолюминесценция сильно легированных слоев Ge/Si(001) n-типа проводимости 1293
- Уаман Светикова Т.А., Иконников А.В., Румянцев В.В., Козлов Д.В., Черничкин В.И., Галеева А.В., Варавин В.С., Михайлов Н.Н., Дворецкий С.А., Морозов С.В., Гавриленко В.И.
Эволюция примесной фотопроводимости в эпитаксиальных пленках CdHgTe при изменении температуры 1297
- Иконников А.В., Черничкин В.И., Дудин В.С., Акопян Д.А., Акимов А.Н., Климов А.Э., Терещенко О.Е., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.
Особенности спектров примесной фотопроводимости эпитаксиальных пленок PbSnTe(In) при изменении температуры 1303